

Кандидат в академики РАН
по Отделению физических наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «физика»

ДВУРЕЧЕНСКИЙ Анатолий Васильевич

Заведующий лабораторией неравновесных полупроводниковых систем ФГБУН Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск), р. 10.04.1945, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, Государственная премия СССР, премия Правительства РФ, международная премия АН СССР и АН ГДР, почетная грамота Президента РФ

Двуреченский А.В. – специалист в области физики полупроводников, радиационной технологии, автор и соавтор 511 научных работ, из них 10 авторских свидетельств и 8 патентов. После избрания членом-корреспондентом РАН в 2008 г. - 191 научная работа, включая 3 патента.

Основные научные результаты Двуреченского А.В.:

- установлены закономерности воздействия мощного импульсного лазерного излучения и электронных пучков на полупроводники («лазерный отжиг»), фазовые превращения в сильнонеравновесных условиях быстрого нагрева и последующего охлаждения системы;
- разработаны методы роста из ионно-молекулярных пучков гетероструктур кремний/германий с квантовыми точками с управляемым их пространственным расположением и однородностью по размерам;
- обнаружены электронные и спиновые явления в массивах туннельно-связанных квантовых точек, характеризующихся переносом заряда и наложением полей неоднородных деформаций;
- разработаны подходы к созданию кубитов на квантовых точках.

Двуреченский А.В. – профессор кафедры «Физика полупроводников» в Новосибирском государственном университете, им подготовлены 4 доктора и 12 кандидатов наук.

Двуреченский А.В. – заместитель председателя Научного совета РАН (Отделение физических наук РАН) по проблеме “Радиационная физика твердого тела”, член бюро Объединенного ученого совета СО РАН по физическим наукам, член редколлегии журнала «Известия ВУЗов: материалы электронной техники»

Двуреченский А.В. выдвинут кандидатом в академики РАН по Отделению физических наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности "физика" Ученым советом ФГБУН Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН и академиком РАН Чапликом А. В.